



华晶分立器件

3DD1545

低频放大管壳额定双极型晶体管

1 概述与特点

3DD1545 硅 NPN 型高反压大功率晶体管, 主要用作 21 英寸彩电开关电源, 该产品采用台面结构工艺。其特点如下:

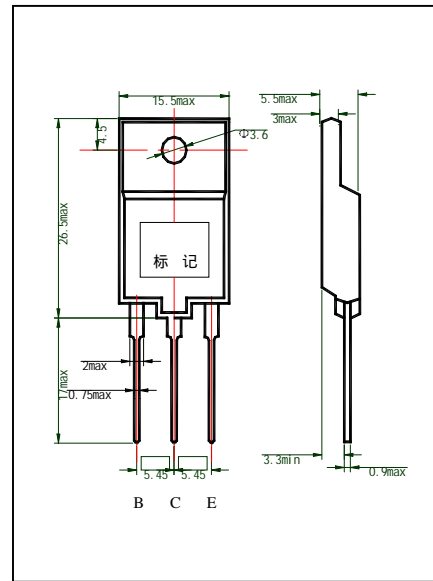
- 击穿电压高、漏电流小
- 开关速度快
- 饱和压降低
- 电流特性好
- 封装形式: TO-3P(H)IS

2 电特性

2.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}C$

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-发射极电压	$V_{CE0}$	600	V
集电极-基极电压	$V_{CB0}$	1500	V
发射极-基极电压	$V_{EB0}$	5	V
集电极电流	$I_C$	5	A
耗散功率	$T_a=25^{\circ}C$	3	W
	$T_c=25^{\circ}C$	50	
结温	$T_j$	150	$^{\circ}C$
贮存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}C$



2.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}C$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=1500V, I_E=0$			1	mA
发射极-基极截止电流	$I_{EB0}$	$V_{EB}=5V, I_C=0$			10	$\mu A$
共发射极正向电流传输比的静态值	$h_{FE}^a$	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	8			
集电极-发射极饱和电压	$V_{CEsat}^a$	$I_C=4A, I_B=0.8A$			5	V
基极-发射极饱和电压	$V_{BEsat}^a$	$I_C=4A, I_B=0.8A$			1.5	V
下降时间	$t_f$	$V_{CC}=105V, I_C=4A$ $2I_{B1}=-I_{B2}=0.8A$			1	$\mu s$
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=10V, I_C=100mA$ $f=0.3MHz$	1			MHz

a: 脉冲测试  $t_p \leq 300 \mu s, \delta \leq 2\%$

无锡华晶微电子股份有限公司

地址: 江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话: (0510)5807228-2268、2299 传真: (0510)5800360

### 3 特性曲线

